МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА

СЕМЕНОВ АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

УДК 538.956; 537.9; 544.72.05; 544.77

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОФАЗНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

01.04.02 — теоретична фізика

ΑΒΤΟΡΕΦΕΡΑΤ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі теоретичної фізики і астрономії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Сушко Мирослав Ярославович, доцент кафедри теоретичної фізики та

астрономії, Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова.

Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор

Лебовка Микола Іванович,

Інститут біоколоїдної хімії ім. Φ .Д. Овчаренка НАН України, завідувач відділу фізичної хімії

дисперсних мінералів;

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Лисенков Едуард Анатолійович, доцент кафедри математичного аналізу,

Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського.

Захист дисертації відбудеться «»	2020 р. о годи-
ні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 4	41.051.04 Одеського націо-
нального університету імені І.І.Мечникова за	адресою: 65082 м. Одеса,
вул. Пастера, 27, ОНУ імені І.І.Мечникова, Ве	елика фізична аудиторія.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за адресою: 65026 м. Одеса, вул. Преображенська, 24 та на сайті: http://theorphys.onu.edu.ua/thesises.

Автореферат розісланий «___» ______ 2020 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.051.04 кандидат фізико-математичних наук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальність роботи визначається як нагальними практичними задачами створення та застосування нових композитних матеріалів з бажаними та контрольованими електрофізичними властивостями (наприклад, тверді композитні та полімерні композитні електроліти), суттєво відмінними від властивостей природних речовин, так і необхідністю побудови і вдосконалення надійних теоретичних моделей для кількісного опису та діагностики їх характеристик.

Робота присвячена побудові та аналізу теоретичної моделі для опису найменш дослідженого, але найбільш поширеного типу тривимірних невпорядкованих систем, утворених диспергуванням частинок наповнювача в несучу матрицю. Ключовими проблемами, далекими до свого розв'язання, при створенні послідовної теорії таких систем є врахування різного роду міжфазних ефектів (нерегулярність форми частинок; контактний опір; утворення оксидних шарів; формування високопровідних областей з підвищеною концентрацією дефектів чи іонів; аморфізація полімерної матриці тощо), змін властивостей самої матриці (внаслідок неконтрольованого легування, забруднення, змін внутрішньої структури тощо) та послідовний розрахунок багаточастинкових поляризаційних та кореляційних ефектів.

Побудована в дисертаційній роботі аналітична теорія ефективного квазістатичного електричного відгуку невпорядкованих систем частинок з морфологією тверде ядро-проникна оболонка є багаточастинковою та дозволяє враховувати вплив міжфазних та матричних ефектів через моделювання одночастинкового електричного профілю комплексної діелектричної проникності оболонок. Здобуті основні теоретичні співвідношення між ефективною статичною електричною провідністю системи та електричними і геометричними параметрами компонентів підтверджуються результатами їх порівняння з існуючими даними симуляцій методом Random Resistor Network (RRN) та спроможністю адекватно описувати широкі масиви експериментальних даних для ефективної квазістатичної провідності твердих композитних і полімерних композитних електролітів, ефективних електричної провідності та діелектричної проникності в околі порогу електричної перколяції в системі діелектрик-провідник із міжфазним шаром. Теорія також дозволяє показати непослідовність та обмеженість поширеної диференціальної схеми для обчислення ефективних електричних параметрів гетерогенних систем.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі теоретичної фізики і астроно-

мії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, а також є складовою частиною досліджень, які проводились за держбюджетною темою "Дослідження термодинамічних, критичних та кінетичних властивостей рідких металів та їх сплавів" No 0118U000202, а також за держбюджетною темою "Рівняння стану, термодинамічні та кінетичні властивості нанофлюїдів. Дослідження структурування нанофлюїдів на основі кореляційної спектроскопії та спектроскопії діелектричної проникності" No 113U000374.

Мета, задачі, об'єкт, предмет та методи досліджень. *Метою* роботи є побудова теорії ефективних електричних властивостей невпорядкованих дисперсних систем частинок з морфологією тверде ядро-проникна оболонка. У зв'язку з цим були поставлені sadavi:

- 1. Розробити теорію електродинамічної гомогенізації невпорядкованих систем провідних частинок у рамках методу компактних груп $(MK\Gamma)$ [1–4], для чого узагальнити та замкнути $MK\Gamma$ на випадок провідних частинок.
- 2. Проаналізувати в рамках цієї теорії ефективні електричні властивості невпорядкованих систем частинок з морфологією тверде ядро-проникна оболонка та протестувати теорію шляхом порівняння отриманих результатів з даними числових симуляцій.
- 3. Дослідити застосовність теорії до опису електричних властивостей твердих та полімерних композитних електролітів.
- 4. Дослідити застосовність теорії до опису електричної перколяції в дисперсноподібних композитах.
- 5. Виконати критичний аналіз диференціальної схеми обчислення ефективних електрофізичних параметрів гетерогенних систем

Об'ект дослідження: невпорядковані дисперсні системи частинок з морфологією тверде ядро—проникна оболонка.

 $\it Предмет дослідження:$ ефективні електрична провідність та ді
електрична проникність.

Методи дослідження. У роботі був використаний метод компактних груп неоднорідностей [1–4], який дозволяє врахувати багаточастинкові поляризаційні і кореляційні ефекти в довгохвильовому межі, уникаючи деталізації їх розрахунку.

Наукова новизна отриманих результатів. В роботі отримано наступні результати:

— В рамках методу компактних груп неоднорідностей побудовано внутрішньо замкнену статистичну модель квазістатичного електричного відгуку макроскопічно однорідних та ізотропних дисперсних

систем частинок з морфологією типу тверде ядро-проникна оболонка.

- Показано адекватність моделі для опису концентраційних залежностей статичної провідності, отриманих методом числових симуляцій RRN для модельних систем з електрично однорідними та неоднорідними оболонками, та її суттєві переваги над моделям Максвелла-Гарнетта, Бруггемана та Накамури-Нана.
- Показано застосовність теорії до кількісного опису експериментальних даних з ефективної провідності твердих композитних та полімерних композитних електролітів та аналізу ролі різних фізикохімічних механізмів у її формуванні. Внески останніх можна ефективно врахувати через профіль комплексної діелектричної проникності проникних оболонок.
- Показано застосовність теорії до кількісного опису ефективних електричної провідності та діелектричної проникності твердих невпорядкованих композитів в околі порогу електричної перколяції. Встановлено залежність положення порогу перколяції від геометричних параметрів оболонки. Продемонстровано залежність ефективних критичних індексів для таких систем від геометричних та електричних параметрів компонентів та способу обробки експериментальних даних.
- Показано внутрішню непослідовність та загальну обмеженість диференціальної схеми для аналізу ефективних квазістатичних електричних параметрів диспесних систем.

Практичне значення отриманих результатів. Розвинута теорія може розглядатися як новий гнучкий інструмент для аналізу та діагностики як ефективних електрофізичних параметрів невпорядкованих композитних систем, так і існуючих методів їх вивчення.

Особистий внесок здобувача. Три статті [1*, 3*, 4*] виконані у співавторстві з науковим керівником. Загальна постановка задач статей [1*, 3*, 4*] належить доц. Сушку М.Я.. При роботі над цими статтями здобувач брав участь в пошуку та аналізі пов'язаних з ними теоретичних матеріалів та експериментальних даних, виконував з науковим керівником паралельні взаємоконтролюючі теоретичні розрахунки та обробки даних симуляцій та експерименту, брав участь в інтерпретації, аналізі результатів та підготовці їх до опублікування. Також здобувачем було виказано ідею про використання крайових умов для замикання процедури гомогенізації, проаналізовано проблему відображення результатів досліджуваної моделі на результати існуючих комп'ютерних симуляцій, розв'язано

задачу відновлення провідності реальної матриці через параметри дальньої частини модельного профілю провідності оболонки.

Постановка задачі статті $[2^*]$ та її повне розв'язання належать здобувачу.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації доповідалися на семінарах кафедри теоретичної фізики, а також були представлені автором на наукових конференціях/школах/семінарах, з яких дванадцять міжнародних:

- 1. 4-th International Conference on Statistical Physics: Modern Trends and Applications, Lviv, Ukraine, 2012.
- 2. 25-th International Conference: Disperse Systems, Odesa, Ukraine, 2012.
- 3. 5-th International Symposium: Methods and Applications of Computational Chemistry, Kharkiv, Ukraine, 2013.
- 4. 6-th International Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems, Kyiv, Ukraine, 2014.
- 5. 26-th International Conference: Disperse Systems, Odesa, Ukraine, 2014.
- 6. 2015 International Young Scientists Forum on Applied Physics, Dnipropetrovsk, Ukraine, 2015.
- 27-th International Conference: Disperse Systems, Odesa, Ukraine, 2016.
- 8. International conference: Development of innovation in the technical, physical and mathematical fields of sciences, Mykolayiv, Ukraine, 2016.
- 9. 8-th International Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems, Kviv, Ukraine, 2018.
- 10. 5-th International Conference on Statistical Physics: Modern Trends and Applications, Lviv, Ukraine, 2019.
- 7-th International Conference: Nanotechnologies and Nanomaterials, Lviv, Ukraine, 2019.
- 12. 28-th International Conference: Disperse Systems, Odesa, Ukraine, 2019.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, висновків і списку використаних джерел, що містить 81 посилання. Загальний обсяг дисертації—115 сторінок друкованого тексту.

основний зміст роботи

У **Вступі** обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначені мета, завдання, об'єкт, предмет та методи дослідження. Обговорені наукова новизна і практичне значення отриманих результатів.

В першому розділі наведено огляд деяких з основних теорій, що використовуються для вивчення та аналізу електрофізичних властивостей макроскопічно однорідних та ізотропних дисперсних систем: теорія перколяції для квазістатичної провідності й проникності; класичні одночастинкові підходи Максвела-Гарнетта та Бруггемана, що досі часто використовуються та грають роль бази для побудови нових теорії, з яких розглянута теорія Накамури Нана Вічорека для опису концентраційної поведінки композитних електролітів; диференціальній та поступовий (incremental) підходи (DS); багаточастинкові теорія сильних флуктуацій властивостей (strong-property-fluctuation theory, SPFT) та метод компактних груп неоднорідностей (МКГ); межі Хашина-Штрікмана для лінійного відгуку, яким повинна задовільняти кожна теорія для опису невпорядкованих дисперсних систем.

Другий розділ дисертації присвячений розвиненню моделі для опису квазістатичної ефективної комплексної діелектричної проникності немагнітних провідних систем невпорядкованих частинок з морфологією тверде ядро-проникна оболонка (див. рис. 1) в рамках МКГ [1-4]. Ця модель широко відома в літературі та часто використовується при роботі з дисперсними системами, однак її формальні реалізації навіть у найпростішому випадку електрично однорідних оболонок не є тривіальною задачею. Вже при досить невеликих концентраціях перекриття оболонок можуть бути істотними, тож виникає питання чи вважати поляризацію кластера декількох частинок з перекритими оболонками одночастинковою (як для частинки зі складною структурою) чи багаточастинковою. Математично це пов'язано з необхідністю взяття до уваги всіх багаточастинкових вкладів вже на етапі розрахунку об'ємної концентрації таких частинок. Крім цього, постає питання вибору електродинамічної гомогенізації такої системи. МКГ дозволяє ефективно впоратися з цими проблемами у квазістатичному наближенні, на-відміну від SPFT, що передбачає необхідність прямого розрахунку всіх багаточастинкових вкладів вже у другому наближенні теорії збурень.

В **підрозділі 2.1** МКГ був послідовно узагальнений для провідних систем. Частоти падаючого вважалися досить малими, щоб вкладами діелектричних втрат можна було знехтувати (квазістатичне наближення),

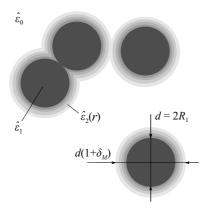


Рис. 1: Схематичне зображення моделі \mathcal{D} системи невпорядкованих частинок з морфологією тверде ядро-проникна оболонка. Розглядається макроскопічно однорідна та ізотропна система сферичних частинок, що знаходяться в однорідній матриці з проникністю $\hat{\varepsilon}_0$ (біла область). Кожна частинка складається з твердого ядра радіусом $R_1 = d/2$ та проникністю $\hat{\varepsilon}_1$ (чорні області), покритого концентричною проникною оболонкою товщиною $R_1\delta_M$ з радіальним розподілом проникності $\hat{\varepsilon}_2 = \hat{\varepsilon}_2(r)$ (сірі області). Всі проникності комплексні та мають структуру (1). Локальне значення проникності визначається відстанню від даної точки до центру найближчої частинки.

що передбачає наступну структуру комплексної проникності:

$$\hat{\varepsilon} = \varepsilon + i \, \frac{4\pi\sigma}{\omega},\tag{1}$$

де ε , σ – відповідно, низькочастотні дійсна частина діелектричної проникності та провідність; символ "хатки" над символом позначає його комплексність. Ефективна комплексна проникність системи $\hat{\varepsilon}_{\rm eff}$ визначалась як коефіцієнт пропорційності між статистичними середніми комплексного струму $\langle {\bf J}({\bf r}) \rangle$ та напруженістю електричного поля $\langle {\bf E}({\bf r}) \rangle$:

$$\langle \mathbf{J}(\mathbf{r}) \rangle = -i \frac{\omega}{4\pi} \langle \hat{\varepsilon}(\mathbf{r}) \mathbf{E}(\mathbf{r}) \rangle = -i \frac{\omega}{4\pi} \hat{\varepsilon}_{\text{eff}} \langle \mathbf{E}(\mathbf{r}) \rangle.$$
 (2)

Показано, як це співвідношення знаходиться з макроскопічних рівнянь Максвелла та рівняння неперервності.

Для знаходження $\langle \mathbf{J} \rangle$ та $\langle \mathbf{E} \rangle$ в рамках МКГ, формально розглядається допоміжна система \mathcal{S} , що складається з модельної системи \mathcal{D} , розташованій у однорідній матриці \mathcal{M} з поки що невідомою проникністю $\hat{\varepsilon}_{\mathbf{f}}$.

Вважається, що відгук S еквівалентний відгуку \mathcal{D} [4]. У квазістатичному наближенні S можна розглядати як сукупність макроскопічних областей (компактних груп) з лінійними розмірами D набагато меншими за довжину хвилі λ в \mathcal{M} , але досить великими, щоб мати властивості всієї S. Тоді локальне значення комплексної проникності можна записати як:

$$\hat{\varepsilon}(\mathbf{r}) = \hat{\varepsilon}_{f} + \delta \hat{\varepsilon}(\mathbf{r}), \tag{3}$$

де $\delta \hat{\varepsilon}(\mathbf{r})$ – внесок компактної групи в точці \mathbf{r} .

Середні поля знайдені як квазістатичне наближення ітераційного рішення рівняння розповсюдження електромагнитної хвилі в \mathcal{S} :

$$\lim_{\omega \to 0} \langle \mathbf{E}(\mathbf{r}) \rangle = \lim_{\omega \to 0} \left[1 + \langle \hat{Q}(\mathbf{r}) \rangle \right] \mathbf{E}_0; \tag{4}$$

$$\lim_{\omega \to 0} \langle \mathbf{J}(\mathbf{r}) \rangle = -i \lim_{\omega \to 0} \frac{\omega \hat{\varepsilon}_{f}}{4\pi} \left[1 - 2\langle \hat{Q}(\mathbf{r}) \rangle \right] \mathbf{E}_{0}, \tag{5}$$

де

$$\hat{Q}(\mathbf{r}) = \sum_{s=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{3\hat{\varepsilon}_{f}} \right)^{s} (\delta \hat{\varepsilon}(\mathbf{r}))^{s}.$$
 (6)

Значення $\hat{\varepsilon}_f$ знаходиться в **підрозділі 2.2** виходячи з граничних умов для нормальних компонент комплексних струмів на межі розділу допоміжної матриці $\mathcal M$ та гомогенізованим середовищем:

$$\hat{\varepsilon}_{\rm f} \mathbf{E}_{0n} = \hat{\varepsilon}_{\rm eff} \langle \mathbf{E}(\mathbf{r}) \rangle_n. \tag{7}$$

Користуючись цією рівністю та виразом (4), відкидаючи нефізичні розв'язки отримано $\hat{\varepsilon}_f = \hat{\varepsilon}_{eff}$, що разом з (2) дає рівняння для ε_{eff} :

$$\langle \hat{Q}(\mathbf{r}) \rangle = 0. \tag{8}$$

Рівняння (8) є строгим у статичному наближенні.

Модель ядро-оболонка (див. рис. 1) в термінах $\delta \hat{\varepsilon}(\mathbf{r})$ розвинена в підрозділі 2.3. Спочатку розглядався випадок електрично однорідного профілю оболонки з зовнішнім радіусом R_2 . При цьому вважалося, що локальне значення комплексної проникності $\hat{\varepsilon}(\mathbf{r})$ залежить від відстані $l=\min\limits_{1\leqslant a\leqslant N}|\mathbf{r}-\mathbf{r}_a|$ від даної точки \mathbf{r} до центру найближчої частинки та визначається одночастинковим профілем останньої. Тоді $\delta \hat{\varepsilon}(\mathbf{r})$ можна записати

в термінах характеристичних функцій відповідних областей:

$$\delta \hat{\varepsilon}(\mathbf{r}) = (1 - \tilde{\chi}_2(\mathbf{r})) \Delta \hat{\varepsilon}_0 + \tilde{\chi}_1(\mathbf{r}) \Delta \hat{\varepsilon}_1 + (\tilde{\chi}_2(\mathbf{r}) - \tilde{\chi}_1(\mathbf{r})) \Delta \hat{\varepsilon}_2, \tag{9}$$

де $\Delta \hat{\varepsilon}_j = [\hat{\varepsilon}_j - \hat{\varepsilon}_{\rm f}] \ (j=0,1,2); \ \tilde{\chi}_1$ та $\tilde{\chi}_2$ – характеристичні функції, відповідно, всіх ядер (всієї чорної області на рис. 1) та частинок разом з їх оболонками (всі чорні та сірі області). За визначенням $\tilde{\chi}_1$ та $\tilde{\chi}_2$, виконуються співвідношення $\tilde{\chi}_1\tilde{\chi}_2 = 0, \ (\tilde{\chi}_1)^s = \tilde{\chi}_1, \ (\tilde{\chi}_2)^s = \tilde{\chi}_2, \ {\rm тому}, \ {\rm моменти} \ \delta \hat{\varepsilon}$ можна записати у наступному вигляді:

$$\langle (\delta \hat{\varepsilon})^s \rangle = (1 - \phi)(\Delta \hat{\varepsilon}_0)^s + c(\Delta \hat{\varepsilon}_1)^s + (\phi - c)(\Delta \hat{\varepsilon}_2)^s, \tag{10}$$

де $c = \langle \tilde{\chi}_1(\mathbf{r}) \rangle$ – об'ємна концентрація ядер; $\phi = \langle \tilde{\chi}_2(\mathbf{r}) \rangle$ – об'ємна концентрація всіх частинок разом з їх оболонками. Для досліджуваної моделі у статистичній рівновазі з точністю до третього віріального коефіцієнту в рамках суперпозиційного наближення Кірквуда [5]:

$$\phi(c,\delta) = 1 - (1-c) \exp\left[-\frac{(1-\psi)\phi_t}{1-c}\right] \times \exp\left[-\frac{3c\phi_t}{2(1-c)^3} \left(2 - 3\psi^{1/3} + \psi - c\left(3\psi^{1/3} - 6\psi^{2/3} + 3\psi\right)\right)\right],$$
(11)

де

$$\phi_t = c(1+\delta)^3 = c/\psi \tag{12}$$

 ϵ об'ємною концентрацією ядер з твердими оболонками ($\psi = (1+\delta)^{-3}$). Авторами стверджується, що результат ϵ точним в даному наближенні.

Далі модель була узагальнена на випадок електрично неоднорідних оболонок. Спершу, розглядається випадок частинок, що складаються з M концентричних однорідних оболонок, кожна m-а з яких має зовнішній радіус $R_{2,m} = R_1(1+\delta_m) \; (R_{m-1} < R_m)$ та проникність $\hat{\varepsilon}_{2,m}; \; \hat{\varepsilon}(\mathbf{r})$ знову ж таки залежить від l за тим самим правилом. Тоді $\delta \hat{\varepsilon}(\mathbf{r})$:

$$\delta \hat{\varepsilon}(\mathbf{r}) = (1 - \tilde{\chi}_{2,M}(\mathbf{r})) \Delta \hat{\varepsilon}_0 + \tilde{\chi}_1(\mathbf{r}) \Delta \hat{\varepsilon}_1 + (\tilde{\chi}_{2,1}(\mathbf{r}) - \tilde{\chi}_1(\mathbf{r})) \Delta \hat{\varepsilon}_{2,1} + \sum_{m=2}^{M} (\tilde{\chi}_{2,m}(\mathbf{r}) - \tilde{\chi}_{2,m-1}(\mathbf{r})) \Delta \hat{\varepsilon}_{2,m},$$
(13)

де $\Delta \hat{\varepsilon}_{2,m} = [\hat{\varepsilon}_{2,m} - \hat{\varepsilon}_{\mathrm{f}}]; \, \tilde{\chi}_{2,m}(\mathbf{r})$ – багаточастинкові характеристичні функції відповідних областей. Переходячи до границь $M \to \infty, \, |\delta_{2,m} - \delta_{2,m-1}| \to 0, \, (\delta_M = \mathrm{const})$ та вимагаючи, щоб $\phi(c,\delta)$ була диференційована за $\delta,$ для систем частинок з кусково-гладкої функції профілю оболонки $\hat{\varepsilon}_2(r)$ отримано:

$$\langle (\delta \hat{\varepsilon})^s \rangle = (1 - \phi(c, \delta))(\Delta \hat{\varepsilon}_0)^s + c(\Delta \hat{\varepsilon}_1)^s + \int_0^{\delta_m} \frac{\partial \phi(c, u)}{\partial u} (\Delta \hat{\varepsilon}_2(u))^s du, \quad (14)$$

де $\Delta \hat{\varepsilon}_2(u)$ є функція $\hat{\varepsilon}_2(r) - \hat{\varepsilon}_{\rm f}$, що виражена в термінах змінної $u = (r-R_1)/R_1$, а δ_M відповідає зовнішній границі оболонки. Для однорідної оболонки ($\Delta \hat{\varepsilon}_2(u) = {\rm const}$) вираз (14) одразу зводиться до (10) при $\delta = \delta_M = \delta_1$.

В підрозділі **2.4** за отриманими результатами попередніх розділів надаються остаточні рівняння для $\hat{\varepsilon}_{\text{eff}}$ в рамках моделей з однорідною та радіально-симетричною неоднорідною оболонками, першу з яких легко отримати з останньої:

$$(1 - \phi) \frac{\hat{\varepsilon}_0 - \hat{\varepsilon}_{\text{eff}}}{2\hat{\varepsilon}_{\text{eff}} + \hat{\varepsilon}_0} + c \frac{\hat{\varepsilon}_1 - \hat{\varepsilon}_{\text{eff}}}{2\hat{\varepsilon}_{\text{eff}} + \hat{\varepsilon}_1} + \int_0^{\delta_M} \frac{\partial \phi(c, u)}{\partial u} \frac{\hat{\varepsilon}_2(u) - \hat{\varepsilon}_{\text{eff}}}{2\hat{\varepsilon}_{\text{eff}} + \hat{\varepsilon}_2(u)} du = 0, \quad (15)$$

підставляючи $\hat{\varepsilon}_2(u) = const.$ Зазначимо, що форма частинок грала роль лише на етапі вибору їх статистичного розподілу, тобто вибору ϕ ; в загальному випадку, результат (15) може бути застосовані до будь-яких багатофазних макроскопічно однорідних та ізотропних систем у квазістатичному наближенні, при належному виборі ϕ .

Наостанок були записані явні вирази для квазістатичних провідності та діелектричної проникності:

$$(1 - \phi)\frac{\sigma_0 - \sigma_{\text{eff}}}{2\sigma_{\text{eff}} + \sigma_0} + c\frac{\sigma_1 - \sigma_{\text{eff}}}{2\sigma_{\text{eff}} + \sigma_1} + \int_0^{\delta_M} \frac{\partial \phi(c, u)}{\partial u} \frac{\sigma_2(u) - \sigma_{\text{eff}}}{2\sigma_{\text{eff}} + \sigma_2(u)} du = 0, \quad (16a)$$

$$(1 - \phi) \frac{\varepsilon_0 \sigma_{\text{eff}} - \varepsilon_{\text{eff}} \sigma_0}{(2\sigma_{\text{eff}} + \sigma_0)^2} + c \frac{\varepsilon_1 \sigma_{\text{eff}} - \varepsilon_{\text{eff}} \sigma_1}{(2\sigma_{\text{eff}} + \sigma_1)^2} + \int_0^{\delta_M} \frac{\partial \phi(c, u)}{\partial u} \frac{\varepsilon_2(u)\sigma_{\text{eff}} - \varepsilon_{\text{eff}} \sigma_2(u)}{(2\sigma_{\text{eff}} + \sigma_2(u))^2} du = 0,$$
(166)

що мають місце за умови $|\sigma_i - \sigma_{\rm eff}| \gg \epsilon_0 \omega(\varepsilon_i + 2\varepsilon_{\rm eff})$. Надалі розглядаються тільки такі системи, для яких ця умова виконується.

Також розглянуто тип гомогенизації Максвелла-Гарнетта $\hat{\varepsilon}_f = \hat{\varepsilon}_0$ в рамках досліджуваної моделі, що не узгоджується з граничними умовами (7), але часто використовується у побудові теоретичних моделей:

$$\frac{\sigma_{\text{eff}} - \sigma_0}{2\sigma_0 + \sigma_{\text{eff}}} = c \frac{\sigma_1 - \sigma_0}{2\sigma_0 + \sigma_1} + \int_0^{\delta_M} \frac{\partial \phi(c, u)}{\partial u} \frac{\sigma_2(u) - \sigma_0}{2\sigma_0 + \sigma_2(u)} du. \tag{17}$$

В розділі 3 тестуються отримані в розділі 2 співвідношення (16а) та (17) між ефективною статичною провідністю та геометричними й електричними параметрами системи. Щоб уникнути урахування різноманітних ефектів, механізмів та неконтрольованих експериментальних похибок, що залежать від конкретного експерименту, використовувалися результати числових симуляцій. Широкий масив даних для тривимірних систем був отриманий в рамках алгоритму Random Resistor Network (RRN) [6–8], де вивчалися залежності провідності систем частинок з морфологією тверде ядро-проникна оболонка, для яких виконувалась нерівність $\sigma_1 \ll \sigma_0 \ll \sigma_2$, від об'ємної концентрації ядер при різних діаметрах ядер та товщинах оболонок для двох випадків: електрично однорідні оболонки [6, 8] та електрично неоднорідними оболонками з профілем провідності, задаваним радіально за Гаусовим законом [7]. Це викладено в підрозділі 3.1, разом із стислим описом самого алгоритму RRN:

- а) генерація досліджуваної тривимірної системи частинок з морфологією тверде ядро-проникна оболонка для бажаної об'ємної концентрації ядер c;
- б) генерація системи кубічних комірок виходячи з попередньо згенерованої моделі, за умови, що об'ємна концентрація c' комірок, що відповідають ядрам, дорівнює c;
- в) побудова ґратки резисторів, властивості яких сформовані розглядаючи відповідні дві сусідні комірки.

Використані параметри симуляцій представлені в тексті дисертації.

Треба зазначити, що переходи між системами а) \rightarrow 6) та б) \rightarrow в) не передбачають зберігання повної еквівалентності як геометричних так і електричних параметрів: при переході а) \rightarrow 6) об'ємна концентрація матеріалу оболонок буде змінюватися через те, що розміри сферичних частинок та кубічних комірок співрозмірні; при переході б) \rightarrow в) сусідні комірки, що знаходяться на межах фаз, будуть створювати додаткові шари з відповідними провідностями та товщиною в одну комірку.

В дисертаційній роботі розглядається проблема еквівалентності лише а) та б), як більш вагома. В **підрозділі 3.1.1** показано, що, якщо виконується рівність c=c', відносна товщина δ у системі а) дорівнює відносній товщині δ' в системі б) з точністю до коефіцієнту K:

$$\delta' = K^{-1}\delta; \qquad k = (\pi/6)^{1/3} \leqslant K \leqslant 1.$$
 (18)

Якщо на одну частинку припадає одна комірка, то K = k; чим більша кількість комірок, тим ближче K до одиниці. В досліджуваних симуляціях [6–8], лінійні розміри комірки a' були 0.5 мкм, а ядер $a \le 11$ мкм,

тож відхилення K від одиниці повинні бути помітними. Необхідність використання параметру K підтверджується порівнянням досить точного результату (11) з даними симуляцій RRN [8] для $(\phi - c)$ (див. рис. 2).

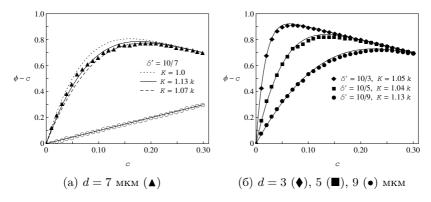


Рис. 2: Дані [8] з об'ємної концентрації оболонок як функції c та їх обробка за (11) для різних K при t=5 мкм. Пусті точки (\circ) на рис. (a) – отримані після симуляції дані для c'. Неперервні лінії – найкращі результати обробки.

Крім цього, для систем з електрично неоднорідними оболонками при переході від а) до б) можуть змінюватися й параметри профілю цих оболонок. В підрозділі 3.1.2 показано, що визначаючи профіль у вигляді наступного гаусового сферично-симетричного розподілу, побудованого за вказівками з [7]:

$$\sigma_2(u) = \sigma_{\text{max}} \exp\left[-\frac{4\left(u - \delta/2\right)^2}{\delta^2} \ln\left(\frac{\sigma_{\text{max}}}{\sigma_{\text{min}}}\right)\right],\tag{19}$$

параметри σ_{\max} , σ_{\min} в системи а) пов'язані з σ'_{\max} , σ'_{\min} в системі б):

$$rac{\sigma_{
m max}}{\sigma_{
m min}} = \left(rac{\sigma_{
m max}'}{\sigma_{
m min}'}
ight)^{(n-2)/n},$$

де n=t/a' є середнє число комірок, що припадають на радіальну товщину оболонки. Ці деталі не були зазначені в роботі [7], тому для обробки даних за (19) один з параметрів вибирався підгінним, а інший — фіксованим; наразі $\sigma_{\rm max}$ був вибраний у якості підгінного.

В підрозділі 3.2 представлена обробка результатів симуляцій RRN [6, 8] з концентраційних залежностей ефективної статичної провідності в

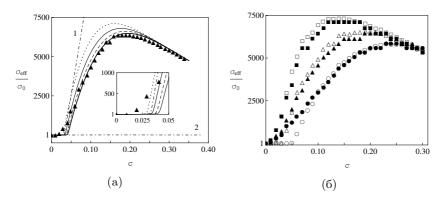


Рис. 3: Дані симуляцій [8] з провідності як функції концентрації ядер c та їх обробка за (16а) для однорідної оболонки при t=5 мкм та (а) різних K (у відповідних позначеннях ліній з рис. 2а; товста неперервна лінія – K=1.03k); (б) пусті точки – отримані результати для відповідних δ при ϕ взятому з симуляцій на рис. 26. Лінія $1-\sigma_{\rm eff}$ використовуючи ϕ для твердих оболонок (12) при K=1.07k; лінія 2- розрахунок $\sigma_{\rm eff}$ за отриманим рівняння типу Максвелла-Гарнетта (17) при K=1.03k.

рамках моделі однорідної оболонки при різних значеннях радіусів ядер та товщин оболонок (див. рис. 3 та 4). Єдиним підгінним параметром виступав K. Зазначимо, що використання значень ϕ , отриманих на рис. 2, дає трохи завищені результати, що може бути пов'язано зі зменшенням об'ємної долі високопровідних оболонок при переході від системи б) до в); цим ефектом можна знехтувати належно вибираючи значення K. При цьому, використання ϕ для твердих оболонок (12) не дає бажаного навіть якісного результату (див. криву 1 на рис. 3а); використання підходу Максвелла-Гарнетта (17) (див. криву 2 на рис. 3а) дає якісний результат (на рисунку це не видно), але далеко не кількісний.

З рис. З видно, що при $c\gtrsim 0.07$ дані досить добре узгоджуються з теорією. До цієї концентрації система демонструє перколяційних перехід, де поріг перколяції c_c в рамках нашої моделі може бути оцінений із співвідношення $\phi(c_c,\delta)=1/3$ (див. Розділ 5): d=5 мкм – $c_c=0.020$ (K/k=1.04), d=7 мкм – 0.034 (K/k=1.07) та d=9 мкм – 0.046 (K/k=1.13). З даних симуляцій видно, визначити c_c майже неможливо, що пов'язано з тим, що c_c в обмежених системах є випадковою негаусовою величиною [9].

Використовуючи отриманий результат також відновлені дані всіх десятьох серій симуляцій [6] (див. рис. 4).

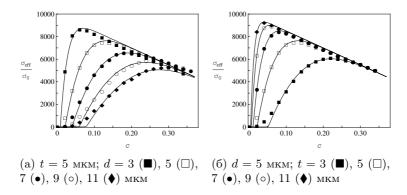


Рис. 4: Дані симуляцій [6] з провідності як функції концентрації ядер c. Використані параметри наведені в дисертаційній роботі.

В підрозділі 3.2.1 робиться аналіз екстремальної поведінки $\sigma_{\rm eff}$ для розглянутих симуляцій. Знайдено, що умова положення максимуму провідності $c_{\rm max}$ для моделі однорідних оболонок співпадає з умовою положення максимум об'ємної концентрації оболонок $\phi-c$:

$$\left. \frac{\partial \phi(c,\delta)}{\partial c} \right|_{c=c_{\text{max}}} = 1. \tag{20}$$

В підрозділі 3.3 результат (16а) тестується на даних симуляцій RRN [7] для неоднорідного гаусового профілю, проаналізованого в підрозділі 3.1.2.3 урахуванням останнього, вдається відновити ввесь спектр даних симуляцій (див. рис. 5). Відхилення пов'язані з вже вказаними ефектами: неточність кількісного визначення c_c для вибраних симуляцій; поява нових оболонок при переході δ) \to в). Останнім ефектом для електрично неоднорідних оболонок неможливо вже знехтувати просто вибираючи K, через те, що майже вся оболонка радіально складається з пар сусідніх комірок, що мають різну провідність.

В розділі 4 розроблена модель застосовується для обробки та аналізу даних з концентраційної та температурної залежностей квазістатичної провідності невпорядкованих систем типу твердих композитних та полімерних композитних електролітів. Процедура обробки описана в підрозділі 4.1 та передбачає використання трьох різновидів одночастинкового профілю $x_2(u) = \sigma_2(u)/\sigma_0$: 1) однорідна оболонка з провідністю $x_{2,1} = \sigma_{2,1}/\sigma_0$ та товщиною δ_1 ; 2) подвійна або потрійна оболонки; 3) неперервна гладка оболонка типу сигмоїд, що "згладжує" дві попередні.

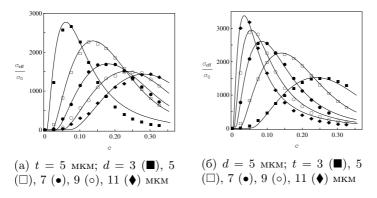


Рис. 5: Точки: результати симуляцій [7] концентраційної залежності провідності систем частинок з гаусовим профілем оболонок. Неперервні лінії: теоретичні результати (16a) в рамках профілю (19).

В підрозділі 4.2 ця процедура застосовується до обробки експериментальних даних [10] концентраційної залежності ефективної провідності твердого композитного електроліту, що складається з частинок $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$ у матриці LiI (див. рис. 6). Показано, що дальню частину профілю на рис. 6б зверху можна трактувати, як ефективний прояв концентраційної залежності провідності матриці $\sigma_0^* = \sigma_0(c)$ (див. рис. 6б знизу), що співпадає з концентраційною залежністю ефективної провідністю в доперколяційній області. Товщина $\delta_1 \approx 0.4$ та провідність $x_{2,1} \approx 185$ ближньої частини профілю дуже добре узгоджується з результатами аналізу розподілу просторового заряду для таких систем [11,12]: $\delta_1 \approx 0.4, x_{2,1} \approx 324$.

В підрозділі 4.3 розглядаються концентраційні та температурні залежності ефективної провідності для полімерних композитних електролітів [13,14] на основі поліетилен-оксиду (PEO) та оксіметилену, зв'язаного з PEO, (ОМРЕО) з солями NaI й LiClO₄. В якості наповнювачів виступали провідні (Na_{3.2}Zr₂P_{0.8}Si_{2.2}O₁₂ (NASICON)) чи непровідні (θ Al₂O₃) частинки, або полімер іншого сорту (поліакриламінід (PAAM)), що не змішується з полімером матриці.

З представленої в **підрозділі 4.3.1** обробки концентраційної залежності ефективної провідності таких систем (див. рис. 7, 8), можна зробити висновок, що $\sigma_{\rm eff}$ формується за рахунок наступних механізмів:

Аморфізація полімерної матриці навколо частинок дисперсної фази – підвищення провідності цієї області у порівнянні з провідністю матриці.

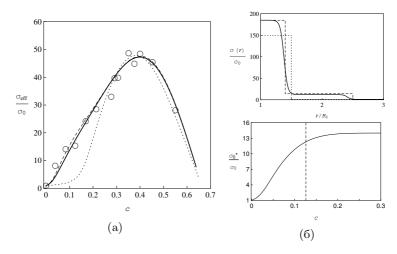


Рис. 6: (а) Експериментальні дані [10] (о) з $\sigma_{\rm eff}$ для ТКЕ LiI/Al₂O₃ та їх обробка в рамках а) однорідної (точкова лінія), б) (зверху) подвійної (штрихована лінія) та в) сигмойдної (неперервна лінія) моделей профілів $\sigma_2(r)$. Використані параметри приведені в тексті дисертації. (б) зверху — відповідні профілі оболонок; знизу — залежність провідності матриці від c (неперервна лінія) для подвійного профілю зверху (штрихована лінія: поріг перколяції $c_c \approx 0.126$).

- 2. Вплив твердості дисперсної фази на аморфізовану фазу матриці зниження провідності матриці у найближчій до поверхні області.
- 3. Формування низькопровідного шару на межі розділу дисперсної та полімерної фаз ефективне зниження провідності першої.

Пік з подальшою западиною профіля для композиту на основі ОМРЕО з РААМ (див. рис. 86) пояснюється тим, що якщо чистий полімер, з якого складається матриця, має відносно високу провідність (наприклад, аморфізований ОМРЕО по відношенню до напівкристалічного РЕО), тоді додавання полімеру, що має низьку провідність в даній системі, (такого як РААМ) може істотно знизити провідність першого (наприклад, за рахунок формування комплексів катіонів Li⁺ та малих кластерів РААМ).

В підрозділі 4.3.2 вивчалася температурна залежність ефективної провідності систем OMPEO–LiClO₄–PAAM [14] в рамках моделі з потрійною оболонкою. Вважалося, що від температури залежать лише провідність аморфізованої матриці σ_0 та параметри $\sigma_{2,i}$ (i=1,2,3) використаного профілю провідності області аморфізованого полімеру навколо

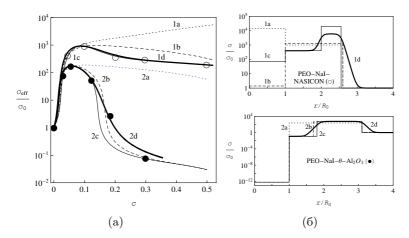


Рис. 7: (а) Експериментальні дані з $\sigma_{\rm eff}$ як функції від c для ПКЕ РЕО-NaI-NASICON [13] (\circ) та (PEO)₁₀-NaI- θ -Al₂O₃ [14] (\bullet), та їх підгонки в рамках моделей однорідної, подвійної та неперервної оболонок. Позначення вказують на відповідні параметри, що приведені у тексті дисертації. (б) Відповідні одночастинкові профілі провідності, що були використані для моделювання мезоскопічної структури ПКЕ.

частинок за емпіричним законом Фогеля-Таммана-Фульхера (VTF). Параметри VTF для кожної компоненти знаходилися з обробки даних концентраційної залежності для трьох ізотерм (див. рис. 9). Всі ці отримані параметри для оболонок лягають у допустимі границі, вказані у [14] для всіх зразків ОМРЕО-LiClO₄-PAAM. З цієї точки зору наші результати узгоджені. Далі, використовуючи знайдені параметри, будувалися температурні ізохори для п'яти значень c (див. рис. 96), чотири з яких із задовільною точністю відновили відповідні експериментальні залежності.

В розділі 5 досліджується ефект електричної перколяції в рамках моделі з однорідними оболонками для систем типу діелектрик-провідник ($\sigma_0 < \sigma_2 \leqslant \sigma_1$). Поріг та критичні індекси перколяції, поведінка діелектричної проникності та ефект подвійної перколяції аналізуються в **підрозділі 5.1.** В **підрозділі 5.1.1** отримано, що при $x_0 \to 0$ єдиний фізично послідовний нетривіальний результат можливий тільки за умови

$$\phi(c_c, \delta) = \frac{1}{3},\tag{21}$$

що відповідає умові на знаходження порогу перколяції c_c .

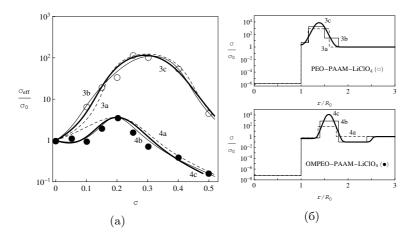


Рис. 8: (а) Експериментальні дані з $\sigma_{\rm eff}$ як функції від c для ПКЕ РЕО–LіСІО₄–РААМ [13,14] (\circ) та ОМРЕО–LіСІО₄–РААМ [14] (\bullet), та їх підгонки в рамках моделей подвійної, потрійної та неперервної оболонок. Позначення вказують на відповідні параметри, що приведені у тексті дисертації. (б) Відповідні одночастинкові профілі провідності, що були використані для моделювання мезоскопічної структури ПКЕ.

В підрозділі 5.1.2 показано, що критичні індекси перколяції s та t, що на практиці визначаються на деякому концентраційному інтервалі в околі c_c , не несуть універсальний характер. Щоб це показати, s та t розглядалися як ефективні величини, що залежать від інтервалу $[c_1, c_2]$ їх вимірювання. Показано, що отримані результати відновлюють відповідні відомі значення теоретичних $(t \approx 1.3 \div 1.7 \ [15]; t \approx 1.9, 2.14, s \approx 0.75 \ [16, 17])$ та експериментальних $(t \approx 1.5 \div 2, s \approx 0.7 \div 1.0 \ [18])$ даних.

В підрозділі 5.2 проаналізовано поведінку квазістатичної діелектричної проникності в околі порогу перколяції при звичайній та подвійній перколяціях. Показано, що максимум квазістатичної проникності виникає у точці перколяційного переходу за умови, що контраст значень провідностей слабкопровідної та вископровідної (перколяційної) компоненти, по відношенню до першої, великий. З аналізу виразу для провідності в підрозділі 5.2.1 отримано, що перший перколяційних перехід виникає за рахунок оболонок, а другий — за рахунок ядер.

В підрозділі **5.3** в рамках моделі з електрично однорідними оболонками оброблені дані з концентраційних залежностей квазістатичних провідності [19] та проникності [20] нанокомпозитів на основі КСІ з на-

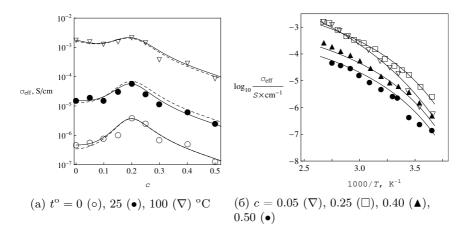


Рис. 9: (а) Експериментальні дані [14] для ізотерм $\sigma_{\rm eff}$ як функції концентрації РААМ та (б) експериментальні дані [14] для ізохор $\sigma_{\rm eff}$ як функції температури для ПКЕ ОМРЕО–LiClO₄–PAAM (з молярною концентрацією LiClO₄ 10 %, після отжигу). Штриховані лінії: підгонки за законом VTF [14] з параметрами, що вказані у Таблиці 5 в [14]. Неперервні лінії: результати наших розрахунків в рамках моделі трьох оболонок, вважаючи, що провідності складових підкоряються закону VTF.

ночастинками Ag ($R_1 \approx 10$ нм), покритими оксидним шаром ($t \approx 1$ нм), що перешкоджав їх злипанню, але дозволяв утворювати контакти металметал під великим тиском (див. рис. 10). З підгонок отримано оцінку для $\delta \approx 0.14 \div 0.18$, що досить близько до експериментальної оцінки ($\delta \approx 0.1$). Крім цього, показано, що побудована модель набагато краще відновлює експериментальні дані з проникності на всьому досліджуваному концентраційному інтервалі ніж скейлінгові співвідношення.

В розділі 6 проводиться критичний аналіз диференціальної моделі (асиметричної моделі Бругемана) квазістатичного електричного відгуку невпорядкованих дисперсних систем в рамках МКГ. Для цього розглядається невпорядкована система діелектричних куль в однорідній діелектричній матриці.

Спочатку в **підрозділі 6.1** показано як відновити класичну асиметричну модель Бругемана (АМБ) для такої системи, в термінах $\delta \varepsilon(\mathbf{r})$ використовуючи (8). Далі в **підрозділі 6.2** побудовано загальну диференціальну

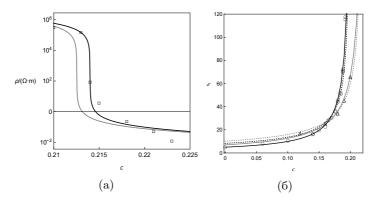


Рис. 10: Дані з ефективного (а) опору [19] та (б) проникності [20] для зразків композитів КСІ–Ад та їх обробка в рамках моделі однорідної оболонки. Параметри оброки вказані в тексті дисертації. Чорна лінія ((а), з права) — модель з проникною оболонкою (11), сіра ((а), зліва) — модель з твердою оболонкою (12). Точкові лінії — скейлінгові підгонки (при $c_c=0.20,\ s_{eff}=0.72$ та $c_c=0.22,\ s_{eff}=0.74$, відповідно) запропоновані в [20] для даних при c>0.11.

схему в термінах $\delta \varepsilon(\mathbf{r})$:

$$\widetilde{\delta\varepsilon}_{\text{CGA}}(\mathbf{r}) = (\varepsilon_0 - (\varepsilon + \Delta\varepsilon))[1 - (\tilde{\chi}_1(\mathbf{r}) + \Delta\tilde{\chi}_1(\mathbf{r}))] + \\
+ (\varepsilon_1 - (\varepsilon + \Delta\varepsilon))[\tilde{\chi}_1(\mathbf{r}) + \Delta\tilde{\chi}_1(\mathbf{r})] \approx \\
\approx \delta\varepsilon_{\text{ABM}}^{(l)}(\mathbf{r}) + \delta\varepsilon_{\text{ABM}}^{(h)}(\mathbf{r}) + \delta\varepsilon_{\text{CGA}}(\mathbf{r}), \tag{22}$$

де були залишені тільки перші порядки малості за $\Delta \tilde{\chi}_1$ (в сенсі його середнього) та $\Delta \varepsilon$. Показано, що в рамках диференціальної схеми ефективний відгук формується трьома внесками: $\delta \varepsilon_{\text{CGA}}(\mathbf{r})$ – внесок заданої компактної групи; $\delta \varepsilon_{\text{ABM}}^{(l)} = -\Delta \varepsilon [1 - \tilde{\chi}_1(\mathbf{r})] + (\varepsilon_1 - \varepsilon) \Delta \tilde{\chi}_1(\mathbf{r})$ враховує вплив нових частинок на $\delta \varepsilon_{\text{CGA}}$; $\delta \varepsilon_{\text{ABM}}^{(h)} = -\tilde{\chi}_1(\mathbf{r}) \Delta \varepsilon - (\varepsilon_0 - \varepsilon) \Delta \tilde{\chi}_1(\mathbf{r})$ враховує вплив зміни матриці $\delta \varepsilon_{\text{CGA}}$.

Класичні закони АМБ можна отримати, якщо знехтувати внесками $\delta \varepsilon_{\rm CGA}$ та $\delta \varepsilon_{\rm ABM}^{(h)}$ (або $\delta \varepsilon_{\rm CGA}$ та $\delta \varepsilon_{\rm ABM}^{(l)}$). Це можливо лише за умов, що 1) концентрація компоненту, що додається, мала; 2) різниці між діелектричними проникностями компонентів малі. Якщо притримуватися тільки першої умови, як це робиться в класичних моделях, то внесками $\delta \varepsilon_{\rm CGA}$ знехтувати неможливо, що призводить до нових узагальнених співвідношень АМБ. Це показано в підрозділі 6.2.1.

В підрозділі 6.3 показано, що отримані узагальнення АМБ не задовільняють межам Хашина-Штрікмана для діелектричної проникності, що свідчить про непослідовність перших; класичні АМБ задовільняють цим межам, але вони за визначенням застосовні лише до дуже вузького класу систем, що визначається зазначеними умовами.

висновки

Основні висновки з результатів роботи наступні.

- Макроскопічні електричні властивості дисперсних систем суттевим чином визначаються геометриними та електричними параметрами міжфазних шарів та можуть бути кількісно описані в рамках статистичної моделі ефективного електричного відгуку невпорядкованих систем частинок з морфологією тверде ядро—проникна оболонка, побудованої в роботі шляхом узагальнення методу компактних груп на такі модельні системи.
- Отримані рівняння для ефективної статичної провідності в достатній мірі точні для розглянутих модельних систем, що підтверджуються результатами порівняння їх розв'язків з даними симуляцій, отриманими методом Random Resistor Network.
- Отримані з кількісного опису експериментальних даних для квазістатичної провідності різних типів твердих композитних та полімерних композитних електролітів та провідності й проникності композитів типу діелектрик-провідник одночастинкові профілі провідності враховують вплив основних фізико-хімічних механізмів в системі та можуть бути використані для їх аналізу.
- Положення порогу електричної перколяції в моделі визначається відносною товщиною оболонки, а значення ефективних критичних індексів залежать як від геометричних та електричних параметрів компонентів, так і способу обробки експериментальних даних, а тому демонструють широкий спектр значень.
- Диференціальна схема аналізу ефективних квазістатичних електричних параметрів диспесних систем є внутрішньо непослідовою та застосовною лише для систем з малими різницями діелектричних проникностей компонентів та вузьких концентраційних інтервалів диспергованих частинок.

Таким чином, розроблена модель ϵ гнучким інструментом для обробки та електроспектроскопічного аналізу невпорядкованих дисперсних систем різного типу.

СПИСОК ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації в наукових журналах:

[1*] Sushko M. Ya. Conductivity and permittivity of dispersed systems with penetrable particle-host interphase / M. Ya. Sushko, A. K. Semenov // Cond. Matter Phys. — 2013 — Vol. 16 — No. 1 — 13401 — P. 1-10. (SJR Q3)

doi: 10.5488/CMP.16.13401

- [2*] Semenov A. K. On applicability of differential mixing rules for statistically homogeneous and isotropic dispersions / A. K. Semenov // J. Phys. Commun. -2018. Vol. 2. No. 3-035045. P. 1-8. doi: 10.1088/2399-6528/aab060
- [3*] Sushko M. Ya. A mesoscopic model for the effective electrical conductivity of composite polymeric electrolytes. / M. Ya. Sushko, A. K. Semenov // J. Mol. Liq. 2019. Vol. 279 P. 677-686. (SJR Q1) doi: 10.1016/j.molliq.2019.02.009
- [4*] Sushko M. Ya. Rigorously solvable model for the electrical conductivity of dispersions of hard-core–penetrable-shell particles and its applications / M. Ya. Sushko, A. K. Semenov // Phys. Rev. E 2019. Vol. 100. 052601. P. 1-14. (SJR Q1) doi: 10.1103/PhysRevE.100.052601

Тези доповідей на наукових конференціях:

- Semenov A. Complex permittivity of disperse systems with penetrable particle-host interphase / A. Semenov, M. Sushko // 4-th International Conference on Statistical Physics: Modern Trends and Applications, abstract – Lviv (Ukraine), 2012. – P. 175.
- 2. Семенов А.К. Роль межфазной границы в формировании проводимости и диэлектрической проницаемости мелкодисперсных систем / А.К. Семенов, М.Я. Сушко // 25-th International Conference: Disperse Systems, abstract Odesa (Ukraine), 2012. P. 221.
- 3. Sushko M. Ya. Finding the parameters of the interphase layers in fine dispersions with dielectric spectroscopy studies near the electrical percolation threshold / M.Ya. Sushko, A.K. Semenov // 5-th International Symposium: Methods and Applications of Computational Chemistry, abstract Kharkiv (Ukraine), 2013. P. 44.
- Sushko M. Ya. Effect of interphase on the effective electrophysical parameters of fine dispersions and nanofluids / M.Ya. Sushko, A.K. Semenov // 6-th International Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems, abstract Kyiv (Ukraine), 2014. P. 177.

- 5. Семенов А. К. Диэлектрическая проницаемость и проводимость дисперсных систем с неоднородной межфазной границей / А.К. Семенов, М.Я. Сушко // 26-th International Conference: Disperse Systems, abstract Odesa (Ukraine), 2014. Р. 163.
- Semenov A. K. A model for conductivity and permittivity of heterogeneous systems with complex microstructures / A.K. Semenov, M.Ya. Sushko // 2015 International Young Scientists Forum on Applied Physics, abstract – Dnipropetrovsk (Ukraine), 2015. – P. 1.
- 7. Бабий К. А Особенности электрической проводимости дисперсных систем на основе полимерных матриц / К.А. Бабий, А.К. Семенов, М.Я. Сушко // 27-th International Conference: Disperse Systems, abstract Odesa (Ukraine), 2016. Р. 28.
- 8. Семенов А. К. Роль міжфазних шарів у формуванні провідних та діелектричних властивостей дісперсноподібних систем: модель та застосування / А.К. Семенов, М.Я. Сушко // International conference: Development of innovation in the technical, physical and mathematical fields of sciences, abstract Mykolayiv (Ukraine), 2016. P. 21.
- 9. Sushko M. Ya. Effective electrical conductivity of composite polymer electrolytes / M.Ya. Sushko, A.K. Semenov // 8-th International Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems, abstract Kyiv (Ukraine), 2018. P. 81.
- Semenov A. K. Is the classical differential scheme for permittivity of emulsions consistent? / A.K. Semenov // 8-th International Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems, abstract – Kyiv (Ukraine), 2018. – P. 124.
- 11. Sushko M. Ya. Recent developments in the theory of electrodynamic homogenization of random particulate systems / M.Ya. Sushko, A.K. Semenov // 5-th International Conference on Statistical Physics: Modern Trends and Applications, abstract Lviv (Ukraine), 2019. P. 160.
- 12. Semenov A. K. Hard-core–penetrable-shell model for effective electric parameters of random particulate systems / A.K. Semenov, M.Ya. Sushko // 7-th International Conference: Nanotechnologies and Nanomaterials, abstract Lviv (Ukraine), 2019. P. 257.
- 13. Семенов А. К. Моделювання електрофізичного відгуку дисперсних систем з твердим дисперсійним середовищем / А.К. Семенов, М.Я. Сушко // 28-th International Conference: Disperse Systems, abstract Odesa (Ukraine), 2019. P. 90.

СПИСОК ЦИТОВАНИХ РОБІТ

- [1] Сушко, М.Я. О диэлектрической проницаемости суспензий М.Я. Сушко // ЖЭТФ. 2007. Т. 132. С. 478–484.
- [2] Сушко, М.Я. Метод компактных групп в теории диэлектрической проницаемости гетерогенных систем / М.Я. Сушко, С.К. Криськив // ЖТФ. 2009. Т. 79. С. 97–101.
- [3] Sushko, M.Ya. Effective permittivity of mixtures of anisotropic particles / M.Ya. Sushko // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2009. – Vol. 42. – P. 155410.
- [4] Sushko, M.Ya. Effective dielectric response of dispersions of graded particles / M.Ya. Sushko // Phys. Rev. E. -2017. Vol. 96. P. 062121, 8 p.
- [5] Rikvold, P. D-dimensional interpenetrable-sphere models of random twophase media: Microstructure and an application to chromatography / P. Rikvold, G. Stell // J. Coll. and Int. Sci. — 1985. — Vol. 108. — P. 158.
- [6] Siekierski, M. Modeling of conductivity in composites with random resistor networks / M. Siekierski, K. Nadara // Electrochimica Acta. 2005. Vol. 50. P. 3796.
- [7] Siekierski, M. Conductivity simulation in composite polymeric electrolytes / M. Siekierski, K. Nadara, P. Rzeszotarski // J. New Mat. Electrochem. Systems. 2006. Vol. 9. P. 375.
- [8] Siekierski, M. Mesoscale models of ac conductivity in composite polymeric electrolytes / M. Siekierski, K. Nadara // J. Pow. Sour. 2007. Vol. 173. P. 748.
- [9] Berlyand, L. Non-Gaussian Limiting Behavior of the Percolation Threshold in a Large System / L. Berlyand, J. Wehr // Commun. Math. Phys. — 1997. — Vol. 185. — P. 73.
- [10] Liang, C. C. Conduction characteristics of the lithium iodide-aluminum oxide solid electrolytes / C. C. Liang // J. Electrochem. Soc. 1973. Vol. 120. P. 1289.
- [11] Jiang, Sh. A theoretical model for composite electrolytes I. Space charge layer as a cause for charge-carrier enhancement / Sh. Jiang, B. Jr. Wagner // J. Phys. Chem. Solids. -1995. Vol. 56. P. 1101.
- [12] Jiang, Sh. A theoretical model for composite electrolytes II. Percolation model for ionic conductivity enhancement / Sh. Jiang, B. Jr. Wagner // J. Phys. Chem. Solids. — 1995. — Vol. 56. — P. 1113.
- [13] Przyluski, J. Effective medium theory in studies of conductivity of composite polymeric electrolytes / J. Przyluski, M. Siekierski, W. Wieczorek // Electrichimica A. -1995. Vol. 40. P. 2101.

- [14] Wieczorek, W. Polyether, Polyacrylamide, LiClO4 Composite Electrolytes with Enhanced Conductivity / W. Wieczorek, K. Such, Z. Florjanczyk, J.R. Stevens // J. Phys. Chem. 1994. Vol. 98. P. 6840.
- [15] Kirkpatrick, S. Percolation and Conduction / S. Kirkpatrick // Rev. Mod. Phys. -1973. Vol. 45. P. 574.
- [16] Bernasconi, J. Real-space renormalization of bond-disordered conductance lattices / J. Bernasconi // Phys. Rev. B. 1978. Vol. 18. P. 2185.
- [17] Luck, J. M. A real-space renormalisation group approach to electrical and noise properties of percolation clusters / J. M. Luck // J. Phys. A: Math. Gen. -1985. Vol. 47. P. 5371.
- [18] Nan, C.-W. Physics of inhomogeneous inorganic materials / C.-W. Nan // Prog. Mater. Sci. 1993. Vol. 37. P. 1–116.
- [19] Chen, L. Materials for solid state batteries / L. Chen. World Scientific, Singapore, 1986.
- [20] Grannan, D. Critical Behavior of the Dielectric Constant of a Random Composite near the Percolation Threshold / D. Grannan, J. Garland, D. Tanner // Phys. Rev. Lett. — 1981. — Vol. 46. — P. 375.

АНОТАЦІЯ

Семенов А.К. Електрофізичні властивості багатофазних дисперсних систем. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 — теоретична фізика. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, МОН України, Одеса, 2020.

В роботі досліджуються ефективні квазістатичні провідність і проникність невпорядкованих тривимірних систем частинок з морфологією тверде ядро-проникна оболонка в рамках моделі, побудованої на основі методу компактних груп. Останній дозволяє врахувати багаточастинкові поляризаційні і кореляційні ефекти без їх деталізації. Оболонки, в загальному випадку, електрично неоднорідні, при цьому їх різні частини ефективно можуть відображати вклади як міжфазних ефектів, так і змін властивостей самої матриці. Електродинамічна гомогенізація здійснювалася використовуючи граничні умови для нормальних компонент струму.

Результати протестовані на даних численних симуляцій, отриманих методом Random Resistor Network. Показано, що отримані співвідношення можуть адекватно описувати широкі масиви даних для ефективної

квазістатичної провідності твердих композитних і полімерних композитних електролітів та ефективні провідність і діелектричну проникність в околиці порога перколяції в системах типу діелектрик-провідник з міжфазним шаром. Так само, показано непослідовність і обмеженість поширеною диференціальної схеми дослідження гетерогенних систем.

Ключові слова: метод компактних груп, модель ядро-оболонка, електрична провідність, діелектрична проникність, дисперсна система, перколяція, композитні електроліти, нанокомпозити, диференціальний метод

АННОТАЦИЯ

Семенов А.К. Электрофизические свойства многофазных дисперсных систем. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.02 — теоретическая физика. Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, МОН Украины, Одесса, 2020.

В работе исследуются эффективные квазистатические проводимость и проницаемость неупорядоченных трехмерных систем частиц с морфологией твердое ядро-проницаемая оболочка в рамках модели, построенной на основе метода компактных групп. Последний позволяет учесть многочастичные поляризационные и корреляционные эффекты без их детализации. Оболочки, в общем случае, электрически неоднородные, при этом их разные части эффективно могут отображать вклады как межфазных эффектов, так и изменений свойств самой матрицы. Электродинамическая гомогенизация осуществлялась используя граничные условия для нормальных компонент тока.

Результаты протестированы на данных численных симуляций, полученных методом Random Resistor Network. Показано, что полученные соотношения могут адекватно описывать широкие массивы данных для эффективной квазистатической проводимости твердых композитных и полимерных композитных электролитов и эффективные проводимость и диэлектрическую проницаемость в окрестности порога перколяции в системах типа диэлектрик—проводник с межфазным слоем. Так же, показано непоследовательность и ограниченность распространенной дифференциальной схемы исследования гетерогенных систем.

Ключевые слова: метод компактных групп, модель ядро-оболочка, электрическая проводимость, диэлектрическая проницаемость, дисперсная система, перколяция, композитные электролиты, нанокомпозиты, дифференциальный метод

ABSTRACT

Semenov A.K. Electrophysical properties of multiphase disperse systems. – Qualification scientific paper, manuscript.

Candidate degree (PhD) thesis in Physics and Mathematics Sciences. Speciality 01.04.02 – theoretical physics. Odesa I.I. Mechnikov National University, the MES of Ukraine, Odesa, 2020.

Practical application of composite materials becomes more widespread due to their unique physical properties, which natural substances can not demonstrate. As a result, both the need to solve the problems of creating composite materials with desired and controlled electrophysical properties (e.g. solid composite and polymer composite electrolytes), and the need to build and improve reliable theoretical models for quantitative description and analysis of their characteristics are increasing.

The most sparing and widespread, but the least theoretically researched type of such systems are three-dimensional disordered systems formed by dispersion of filler particles into a carrier matrix. Theoretical study of electrophysical properties of such systems is not a trivial and far from its accurate solution task, since their characteristics are usually the result of various structural and physico-chemical factors and mechanisms, the key of which are: various interphase effects (form irregularities of dispersed particles; contact resistance; oxide layers; formation of highly conductive regions with increased concentration of defects or ions; amorphization of a polymer matrix, etc.), and changes in properties of the matrix itself (as the result of uncontrolled doping, pollution, changes in internal structure, etc.). Moving towards the homogenization problem is further complicated by the need to take into account many-particle polarizations and correlations.

In this thesis a closed theoretical approach to description of the effective quasi-static electrical response of disordered systems of particles with a hard-core–penetrable-shell morphology, dispersed in a homogeneous matrix, was built. The shells are in general electrically inhomogeneous and obey certain overlapping rules. The properties of different parts of the shells are manifested in different concentration intervals, which allows to effectively reflect through them the contribution of corresponding mechanisms. The electro-

dynamic homogenization of the model was carried out using the boundary conditions for normal components of the electric field in terms of the compact groups of inhomogeneities approach, which was generalized to the case of conducting systems. The compact groups approach allows one to take into account many-particle polarization and correlation processes without their detailing, using the field propagator expansion into a singular and principal parts together with the symmetry properties of the considered model. This in fact suggests that the obtained theoretical relationships between the effective static electrical conductivity of the system and the electrical and geometric parameters of its components are rigorous, as evidenced by the results of their comparison with existing simulation data for the studied model systems obtained within a Random Resistor Network algorithm. It is also shown that these relationships are capable of adequately describing the broad arrays of experimental data for the effective quasi-static conductivity of solid composite and polymer composite electrolytes, effective electrical conductivity and dielectric constant around the percolation threshold in a dielectric-conductor system with interphase layer. The theory also allowed us to show the inconsistency and limitations of a widespread differential scheme for calculation the effective electrical parameters of heterogeneous systems.

The developed theory can be considered as a new flexible tool for analysis and diagnostics of both effective electrophysical parameters of disordered composite systems and existing methods of their study.

Key words: compact group approach, core-shell model, electric conductivity, dielectric permittivity, disperse system, percolation, composite electrolytes, nanocomposites, differential scheme

Підп. до друку ??..??.??. Формат $60 \times 84/16$. Гарн. Таймс. Умов.-друк. арк. ??. Тираж 100 прим. Зам. № ???.

Видавець і виготовлювач: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Україна, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12 Тел.: (048) 723 28 39. E-mail: druk@onu.edu.ua Свідоцтво ДК № 4215 від 22.11.2011 р.